

# Information



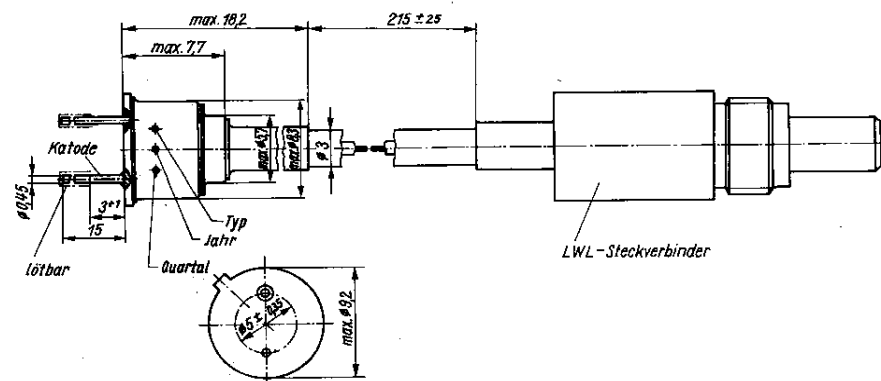
## SP 109

Vorläufige technische Daten

1/84

Hersteller: VEB Werk für Fernsehelektronik Berlin

Die Si-pin-Fotodiode SP 109 ist insbesondere für den Einsatz in der Lichtleiternachrichtenübertragung (Teilnehmeranschlußbereich) bestimmt.



Masse: 30 g  
Standard: TGL 55106

Redaktionsschluß Dezember 1983

Kennwerten bei  $\Phi_a = 25^\circ\text{C}$

Dunkelstrom  $I_{RO}$  min. typ. max.  
bei  $U_R = 20\text{ V}$   $I_{RO}$  - 0,05 2 nA  
 $E = 0$

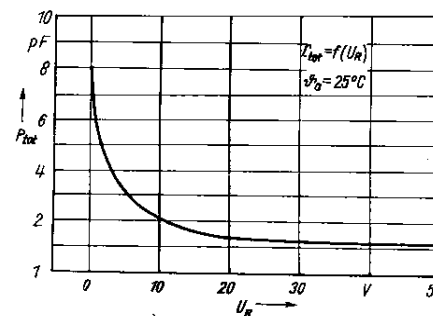
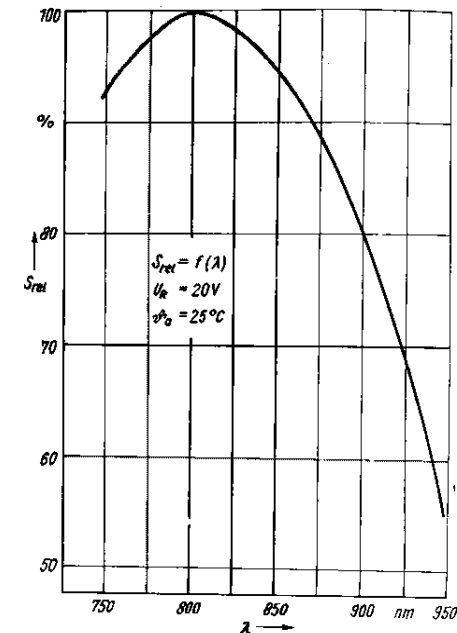
Spektrale Empfindlichkeit  
bei  $\lambda = 850\text{ nm}$   $S$  0,3 0,4 -  $\text{AW}^{-1}$   
 $U_R = 20\text{ V}$

Anstiegszeit  
bei  $U_R = 20\text{ V}$   $t_r$  - 0,5 2 ns  
 $R_L = 50\ \Omega$

Gesamtkapazität  
bei  $f = 1\text{ MHz}$   $C_{tot}$  - 1 2 pF

Grenzwerten

Gesamtverlustleistung  $P_{tot} = 100\text{ mW}$   
Betriebstemperaturbereich  $\Phi_a = -15...+55^\circ\text{C}$   
Lagerungstemperaturbereich  $\Phi_B = -40...+55^\circ\text{C}$



BE-Dr. SP 109: 137 86 22 003 10901B

Die vorliegenden Datenblätter dienen ausschließlich der Information! Es können daraus keine Liefermöglichkeiten oder Produktionsverbindlichkeiten abgeleitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts sind vorbehalten.



Herausgeber:  
veb applikationszentrum elektronik berlin  
im veb kombinat mikroelektronik  
DDR-1035 Berlin, Mainzer Straße 25  
Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2981 011 3055